レーザーイオン源からシンクロトロンにシングルターン入射を行ったときのビーム不 安定性の検討

RESEARCH ON INSTABILITY OF SINGLE-TURN-INJECTED BEAM INTO SYNCHROTRON BY LASER ION SOURCE

野田悦夫#, A), 中尾政夫 A), 野田章 A), 野田耕司 A), 後藤彰 B), 岩井岳夫 B), 山口晶子 C), 佐古貴行 C)

Etsuo Noda^{#, A)}, Masao Nakao^{A)}, Akira Noda^{A)}, Koji Noda^{A)}, Akira Goto^{B)}, Takeo Iwai^{B)}, Akiko Yamaguchi^{C)},

Takayuki Sako C)

^{A)} National Institute of Radiological Sciences

^{B)} Yamagata University

^{C)} Toshiba Corporation

Abstract

Injection of the ion beam into a synchrotron has been studied, extracted from a laser ion source and accelerated by a linac. Single turn injection is required because its operation is intermittent and the ion beam pulse width is usually a few microseconds at the longest. The carbon beam with the emittance of about 1/10 of the synchrotron acceptance was injected off the center in the phase space in the horizontal direction of the synchrotron. The behavior of the off-center injected beam was investigated by a particle trajectory simulation with consideration for space charge effect. The beam instability, integer or half integer resonance caused by magnetic field error, was also investigated theoretically by solving Hill's equation and by using the particle simulation.

1. はじめに

パルスレーザーを固体ターゲットに集光照射して高温 高密度プラズマを発生させ、多価イオンを生成するレー ザーイオン源の開発を行っている。レーザーイオン源は パルス動作をし、プラズマから引き出されたイオンビーム のパルス幅は通常数百 ns~数µs であるためシングル ターン入射を行う必要がある。シンクロトロンに入射したと きのビーム不安定性の解析を、空間電荷を考慮した粒 子軌道シミュレーションにより行った。

2. レーザーイオン源の概要

レーザー照射によって生成されたプラズマはターゲット面にほぼ垂直に、イオン音速程度の速さで膨張する[1]。 プラズマをドリフトチューブと呼ばれる長さ1m程のパイ プ中を飛行させ、パルス幅を1µs 程度まで広げた後、ド リフトチューブ先端に設けた半径数 mm のノズルを通し て、RFQ等の線形加速器中に入射し、4MeV/uまで加速 する。レーザーイオン源からシンクロトロン入射までの概 略図を Figure 1 に示す。本研究では、固体ターゲットに



Figure 1: Schematic diagram of Laser Ion Source.

グラファイトを用いて、ビームパルス幅 1 μ s 、1 パルス当たり 5×10⁹ 個の C⁶⁺ イオンをシンクロトロンにシングル ターン入射することを想定した検討を行った。なお、この 条件でのビーム電流は約 4.8mA となる。

3. シンクロトロンへの入射

3.1 入射方法の概要とビームのエミッタンス整合

前章で述べたように、レーザーイオン源はパルス動作 をし、パルス幅は 1 µ s 程度であるため1パルスのシング ルターン入射を行う。想定しているシンクロトロンのアクセ プタンスは、水平(x)方向 250(π mm·mrad)、垂直(y) 方向 25(π mm·mrad)である。線形加速器を出た後の ビームのエミッタンスは、x, y 方向とも、 $10(\pi \text{ mm·mrad})$ 程度と考えられるため、ビームエミッタンスを拡大する必 要がある。エミッタンス増大の簡便な方法として、薄膜通 過時の散乱を利用する方法がある。炭素薄膜を利用し てエネルギー損失1%以下で、200(πmm·mrad)程度ま で増大するには、膜厚 1μm 以下で、薄膜の幅が 100mm 以上必要となるため、実用的ではない。そこで、 シンクロトロンの水平方向に対し、アクセプタンスの 1/10 程度のエミッタンスまで拡大した C⁶⁺ イオンビームを、シ ンクロトロンの中心を外して入射する方法を提案しその 検討を行った。エミッタンス拡大のためのビームと薄膜の

Га	able 1:	Parameters	for	Emittar	nce E	xpar	ision	by]	Foil

	Х	У	
炭素膜厚 (μm)	厚 (µm) 0.22		
入射ビームエネルギー (MeV)	4		
入射ビームサイズ(全幅) (mm)	18.5	13.5	
入射エミッタンス (πmm·mrad)	8	8	
通過後エミッタンス(πmm·mrad)	25	19	
エネルギーロス(keV/u)	26		
エネルギー広がり (±%)	0.2		
温度上昇ノパルス(K)	2		

[#] gakkai@kasokuki.com

条件を Table 1 に示す。

今回検討したシンクロトロン入射時のビームパラメータ の一覧を Table 2 に示す。シンクロトロンへの入射は ESI (Electrostatic injector)と BMP 磁石を用いて行う。シミュ レーションで用いた BMP 磁石および四重極磁石の配置 を Table 3 に示す。

Table 2: Beam Parameters at Injection

入射ビームのパルス	🗟 1.(μs)						
イオン粒子数	5×10 ⁹ (ppp)						
速度 v _z (4MeV)	2.78.E+07 (m/s)						
速度広がり ⊿v/v	±0.2 (%)						
周長	63.3 (m)						
チューン ν _×	1.79						
Momentum Compaction Factor $0.3(\sim 1/\nu^2)$							
debunching時間(200M	1Hz) 0.6 (μ s) 16.5(m)						
シンクロトロンを1周回	る時間 2.3 (µs)						
ビームが4周分に広か	「るまでの 2851(回)						
周回数と時間	6.5(ms)						

Table 3: Arrangements of BMP-Magnets and Q-Magnets

		-	-	
Γ	Magnet	S(m)	Magnet	S(m)
Γ	Start	0	QD	24.03
	BMPF1	2.59	QF	29.1
	QD	2.93	QD	34.58
	QF	8	QF	39.65
	ESI	10.155	QD	45.13
	INJ	10.65	QF	50.2
	QD	13.48	QD	55.68
	QF	18.55	QF	60.75
	BMPF2	21.49	End	63.3

入射ビームの周回時間は約 $2.3 \mu s$ で、ビームのパル ス幅は $1 \mu s$ であるため、入射時のビームは周長の半分 程度しか占めていない。x 方向のチューン ν_x を 1.79 と するとビームは 4 周で位相空間上のほぼ最初の位置に 戻る。よって、4 周の間に BMP 磁石の磁場をほぼ 0 に戻 せば、ESI にぶつかることなくビームを入射することがで きる。なお、本方式では BMP 磁石の磁場強度は必ずし も直線的に変化する必要はない。

3.2 入射直後の粒子軌道シミュレーション

入射後のビームのx方向の挙動を粒子軌道シミュレー ションにより調べた。シミュレーションは Table 3 に示した ように、BMP 磁石と四重極磁場(QD、QF 各6個)のみを 考慮した直線近似で行い、S=0 から1周に相当する S=63.3 (m) までを1周期として計算を繰り返した。

Figure 2 に BMP 磁石 1 および 2 の磁場強度の時間 変化を示す。



Figure 2: Time variation of BMP magnetic fields.

Figure 3 に入射位置 (s=10.65m) での位相空間上の ビーム位置の周回ごとの変化の様子を示す。 ①から⑧ま での数字は周回数を示しており、 ①が入射時を表してい る。また、 9周目以降のビーム位置は、 灰色の点線の楕 円で 31 周目まで示されている。また、 $\epsilon = 196(\pi \text{ mm} \cdot \text{mrad})$ と表示された黒色の楕円はビームの最外周を結ん だもので、最終的に位相空間内にビームが占める領域 を表している。

シンクロトロン中に入射したビームは自分自身の速度 広がりにより周回とともにビーム長が伸びていき、Table 1 に示すような条件では、約 6.5ms 後にビーム長が周長の 4 倍を超える。このときのビームの分布を Figure 4(a)に、 さらに時間が経過して、ビームがシンクロトロンのアクセ プタンス内の中心部を除いてほぼ一杯に広がった時の ビーム分布を Figure 4(b)に示す。



Figure 3: Time history of beam position for each turn in the phase space with variation of BMP-Magnetic Field.



Figure 4: Beam distributions (a) after 6.5 milliseconds of injection and (b) after beam length fully expands.

シンクロトロン入射後の粒子軌道シミュ レーション

4.1 シミュレーションの概要

BMP 磁石強度が 0 になるまでのシミュレーション結果 については、前章で述べた。ここでは、BMP 磁石強度が 0 になってからの挙動を考える。入射時の x 方向のビー ムエミッタンスはシンクロトロンのアクセプタンスの 1/10 程 度であるため、空間電化の影響が通常より大きくなると考

えらえる。そこで入射時のビームパラメータを中心とし、 必要によってその前後でパラメータを振りながらシミュ レーションを行った。Table 4 にパラメータの範囲を示す。



Figure 5: Cross section of the elliptic beam with uniform charge density.

by Particle Simulations					
	入射時	Parameter 範囲			
<i>a</i> (mm)	13	variable			
<i>b</i> (mm)	11.5	fixed			
\mathcal{E}_{x} (π mm·mrad)	25	fixed			
\mathcal{E}_{y} (π mm·mrad)	19	fixed			
ax	1.03	1.03 ~ 1.35			
$\beta_x(m)$	6.35	6.35 ~ 6.9			
νx	1.79	1.75 ~ 2.05			
I (mA)	5	0~50			

Table 4: Parameters Used

また、正電荷が一様に分布した楕円柱が作る電場は、 以下の(1)式で表され[2]、これを用いて電場の計算を 行った(Figure 5, Table 4 参照)。

$$\vec{E}_{sc}(x,y) = \frac{I}{\pi\varepsilon_0(a+b)\beta c}(\frac{x}{a},\frac{y}{b})$$
(1)

4.2 チューンシフト

空間電荷により発生するチューンシフトの大きさは、 ビーム中心がシンクロトロンの中心に一致しているときは、 Laslett によれば以下の式で表される[3]。

$$\Delta v = \frac{NRr_0Z^2}{\pi Bv b(a+b) \Lambda \beta^2 \gamma^3}$$
(2)

ここで、N はシンクロトロン中の粒子数、R はシンクロト ロン半径、r0 はプロトンの古典半径、Z はイオン価数、B は Bunching Factor、vはチューン、A はイオンの質量数 である。Table 2,4 に示したような実際の重粒子線がん治 療装置で想定されるパラメータを(2)式に入れて Δv を 計算すると

 $\Delta v = 0.039$ $2\pi z_{\odot}$

4.3 空間電荷を考慮した Hill's equation

空間電荷を考慮した Hill の方程式は、空間電荷による発散項を Kss とすると、以下のように表される。

$$x'' + K(s)x - K_{sc}(s)(x - X_0) = 0$$
 (3)

X₀ はビームの中心座標である。また、シンクロトロンの中 心とは必ずしも一致していない。ここで、ビーム中心のま わりの座標をXとすると、x は次のように置ける。

$$x = X_0 + X \tag{4}$$

(4)式を(3)式に代入すると、(3)式は

$$X_0"+X"+K(s)X_0+(K(s)-K_{SC}(s))X=0 \quad (5)$$

となる。(5)式で、すべての粒子の平均をとると、空間電荷

による力は 0 となるので、(5)式は、X₀と X の 2 つの式に 分けられる。

$$X_{0} "+ K(s) X_{0} = 0$$

$$X "+ (K(s) - K_{sc}(s)) X = 0$$
(6)

(6)式より、以下の2つの結果が得られる。

 ビーム中心軌道は、空間電荷の影響を受けない。
 ビーム中心のまわりの粒子の運動は、空間電荷の影響をうけ、ビームをシンクロトロンの中心に入射した時の 軌道と同じになる。

4.4 空間電荷を考慮した粒子軌道シミュレーションと チューンシフト

Table 4 に示したような Parameter 範囲にあるビームをシ ンクロトロンの中心に入射したときのシミュレーション結果 (ν_x =1.75、ビーム電流 I=0 および I=5(mA))を Figure 6 に示す。図中の破線の楕円は、 ϵ_x =25 のビームの最外 周を表しており、最外周上の2つの粒子について 1 周目、 2 周目の位置をプロットした。粒子は楕円上を右回りに回 転しており、I=5(mA)では、I=0 に比べ回転量が小さく なっている。周回当たりの回転量の差からチューンシフト ($\Delta \nu$)を計算した結果を、(2)式の結果とともに Figure 7 に示す。チューシフトの大きさについて、シミュレーション の結果は理論式と一致した。



Figure 6: Trajectory of particles in the phase space injected at the center of the Synchrotron.



Figure 7: Tune shift caused by beam current (i.e. space charge effect) calculated theoretically and by the particle Simulations.

次に、ンクロトロンの中心を外してビームを入射したとき のシミュレーション結果を Figure 8 に示す。Parameter お よび表示の仕方は Figure 6 と同じである

図より、ビーム全体はシンクロトロンの中心の周りに回



Figure 8: Trajectory of particles in the phase space injected off the center of the Synchrotron.

転している。図中の2点鎖線は、ビーム中心の軌道を表している。図よりビーム中心の運動はI=5(mA)とI=0で完全に一致している。また、各粒子は ε x=25の楕円上を右回りに回転しており、その回転量はI=5(mA)とI=0で異なっている。 ε x=25の楕円上の各粒子の運動については、Figure 6と比べると、まったく同じであることが分かる。これより、前節のHillの方程式より導かれた2つの結論、①ビーム中心軌道は、空間電荷の影響を受けない。②ビーム中心のまわりの粒子の運動は、空間電荷の影響をうけ、シンクロトロンの中心に入射した時の軌道と同じになる。これらが、シミュレーションでも確認できた。また、Figure 8 から、空間電荷の影響があるときは、それぞれの粒子については Courant-Snyder 量は保存されていないことが分かる。ただし、全粒子について足し合わせると、エミッタンスは保存されている。

4.5 2 極誤差磁場を考慮した Hill's equation

2 極誤差磁場を考慮した Hill の方程式は、2 極誤差 磁場による力を F₂Bとすると、以下のように表される。

$$x''+K(s)x-K_{sc}(s)(x-X_0) = F_{\Delta B}(s)$$
(7)
ここで、 $F_{\Delta B}(s) = F_{\Delta B}(s+nL)$ (周期条件より)

L はシンクロトロンの周長、n は整数、X₀ はビームの中心 座標である。4.3 節と同じように、ビーム中心のまわりの座 標をXとして、(7)式に代入すると、

$$X_0"+X"+K(s)X_0+(K(s)-K_{SC}(s))X=F_{\Delta B}(s)$$
(8)

 $F_{\Delta B}$ は、すべての粒子に同じように働くので、平均をとった X_0 に対しても同じように働く。よって

$$X_{0} "+ K(s) X_{0} = F_{\Delta B}(s)$$
(9)

(8) - (9) より

$$X'' + (K(s) - K_{SC}(s))X = 0$$
(10)

(9)、(10)式より、以下の2つの結果が得られる。 ① ビーム中心軌道は、2極誤差磁場の影響をうけるが、 空間電荷の影響をうけない。

② ビーム中心のまわりの粒子の運動は、空間電荷の影響をうけるが、2極誤差磁場の影響をうけない。

4.6 4 極誤差磁場を考慮した Hill's equation

4 極誤差磁場を考慮した Hill の方程式は、4 極誤差 磁場による係数を $K_{\Delta B}$ とすると、以下のように表される。

$$x''+K(s)x-K_{SC}(s)(x-X_0) = K_{\Delta B}(s)x$$
(11)
ここで、 $K_{\Delta B}(s) = K_{\Delta B}(s+nL)$ (周期条件より)

X₀はビームの中心座標である。前節と同様に、ビーム中心のまわりの座標をXとして、(11)式に代入すると、

$$X_0"+X"+(K(s)-K_{\Delta B}(s))X_0+(K(s)-K_{\Delta B}(s)-K_{SC}(s))X=0$$
(12)

(12)式を同じように、X0とXの式に分離すると、

$$X_{0}"+K(s)X_{0} = K_{\Delta B}(s)X_{0}$$

$$X"+(K(s)-K_{SC}(s))X = K_{\Delta B}(s)X$$
(13)

(13)式から、以下の2つの結論が導かれる。

① ビーム中心軌道は空間電荷の影響を受けない。さらに、X₀が最初からシンクロトロンの中心にあれば、X₀は0のままとなり、4極誤差磁場の影響を受けない。今回は、シンクロトロンの中心を外したビーム入射を考えているので4極誤差磁場の影響を受ける。

② ビーム中心のまわりの粒子の運動は、空間電荷の影響をうけ、シンクロトロンの中心に入射した時の運動と同じになる。

さらに、エンベロップ方程式を用いると、チューンシフトの大きさと共鳴の関係が導かれ、それによると、x方向と y 方向のチューンが異なる場合には

$$(v - \Delta v / 1.6) = m / 2$$
 (14)

となる[4]。これは、(v-⊿v)が(半)整数となるような⊿ vよりも、さらに 1.6 倍大きな⊿vにならないと共鳴が起 きないことを示している。以上の結果を Table 5 にまとめ

Table 5: Occurrence Cases and Non-Occurrence Cases ofthe Beam Instabilities Caused by Magnetic Field Error

	中心へ入射 (X₀	=0)			中心を外して入射(X	(₀ ≠0)	
	2種誤差磁場				2種誤差磁場		
ν	Δν	X ₀	r x (=a)	ν	ν Δν		r x (=a)
_	0	0	×	-	0	0	×
m	≠0 (<i>v</i> - <u>∕</u> <i>v</i> ≠m)	0	×	m	≠0 (<i>ν</i> - <u>∕</u> <i>ν</i> ≠m)	0	×
<i>+</i>	0	×	×	≠m	0	×	×
≁m	≠0 (<i>ν</i> - <u>⊿</u> <i>ν</i> =m)	×	×		≠0 (<i>v</i> - ∠ <i>v</i> = m)	×	×
	4種誤差磁場			4種誤差磁場			
(0	0	×	0	/2	0	0	0
m/z	≠0 (ν- <u></u> Δν≠m/2)	×	×	m/z	≠0 (ν- <u></u> Δν≠m/2)	0	×
± /2	0	×	×	± /2	0	×	×
≁m/2	≠0 (ν- <u></u> Δν/1.6=m/2)	×	0	≁m/2	≠0 (ν- <u>Δ</u> ν/α=m/2)	x	0
			0	・不安	完性發生 x	・登り	±++ず

4.7 極誤差磁場を考慮した粒子軌道シミュレーションと 不安定性の発生

まず、ビームをシンクロトロン中心に入射してシミュレーションを行った。整数、半整数共鳴を見るために、 $v_x \ge 2$ ~2.05の範囲で変化させた。また、各粒子に対する摂動は s=0~0.1+nL (m) で与えた。Figure 9 に 2 極誤差磁

Proceedings of the 13th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 8-10, 2016, Chiba, Japan

PASJ2016 TUOM03

場、Figure 10 に 4 極誤差磁場でのシミュレーション結果 ($v_x=2$, I=0)を示す。s を横軸に x 方向の変位を示した もので、Figure 9 は周回 500 周目、Figure 10 は 100 周目 を示している。2 極誤差磁場では、ある s のところでビー ムの中心位置が大きく変位している(以後、周回ごとの ビーム中心変位の最大値を最大中心変位と呼ぶ)。一 方、ビーム中心のまわりの運動に相当する半径(本研究 では周回ごとの最大半径の変動に注目)は変化してない。 4 極誤差磁場では、これとは逆に、最大中心変位は 0 の



Figure 9: Horizontal beam trajectory with the dipole magnetic Error.



Figure 10: Horizontal beam trajectory with the quadrupole magnetic Error.

ままで変わらないが、最大半径が大きくなっている。

次に、チューン、ビーム電流、入射位置を変化させて、 不安定性の発生依存性を調べた。最初に、2 極誤差磁 場での結果の一例を Figure 11 に示す。

Figure 9、11 より、最大中心変位は、チューン(v_x)が2 の付近で大きく変動するが、2.035 程度まで離れればほとんど変動は見られなくなる。また、ビーム電流(I)依存はない。一方、最大半径は、 v_x およびIにはよらず、変動は見られなかった。これらの依存性は、中心に入射した場合、中心を外して入射した場合、ともに定量性を含めて同じであった。



Figure 11: Maximum displacement dependences of beam center (left) and maximum radius dependences (right) on beam current with the dipole magnetic Error.

次に、4極誤差磁場での結果をFigure 12、13に示す。 Figure 12より、最大中心変位は、中心に入射した場合は、 v_x およびIによらず変動しない。一方、中心を外して入射した場合、vxが2の付近で中心位置は大きく変動す



Figure 12: Maximum displacement dependences of beam center on tune (left) and on beam current (right) with the quadrupole magnetic Error.





るが 2 極誤差磁場の場合と同じく v_x が 2.035 程度まで 離れればほとんど変動は見られなくなる。また、I 依存性 は無い。最大半径については、Figure 10、13 より、 v_x が 2 の付近で大きく変動するが、同じく、2.035 程度まで離 れればほとんど変動はなくなる。I に対しても依存性があ り、 v_x が 2.035 のとき、I=7.5mA で最大になる。このとき のチューシフト(Δv_x)は 0.06(~0.035×1.7)である。一 方、 Δv_x が 0.035 となる I=4.3mA では、最大半径の変 化はほとんど見られない。中心を外して入射した場合も、 Figure 13 のグラフが完全に重なっていることからも分かる ように、中心に入射した場合と全く同じである。今回のシ ミュレーション結果は、Table 5 の結果と一致した。

以上の結果から、中心を外した入射を行っても、あらか じめチューンを 0.04 程度はずしておけばビーム電流 5mA に対しても特に不安定を引き起こすことなくシング ルターン入射が可能なことが確認できた。

5. 結論

レーザーイオン源からシンクロトロンへのBMP磁 石を用いたシングルターン入射の検討を行った。そ の結果、今回提案した入射方式はシミュレーション 上では実現の可能性があることが確かめられた。

参考文献

- [1] T. P. Hughes, "Plasmas and Laser Light", Published by Adam Hilger, 1975, P.287.
- [2] K. Schindl, "SPACE CHARGE", CERN, CH-1211 Geneva 23.
- [3] L. J. Laslett, "Accelerators and Experimentation at Super-High Energies", Proc. 1963 Summer Study on Storage Rings, Brookhaven (BNL7534), p.324.
- [4] http://accwww2.kek.jp/oho/OHOtxt/OHO-2000/txt-2000-%E2%85%A2.pdf